

トランジスタ

2SD1032, 2SD1032A

2SD1032, 2SD1032A

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形/Si NPN Triple Diffused Planar

低周波電力増幅用/AF Power Amplifier

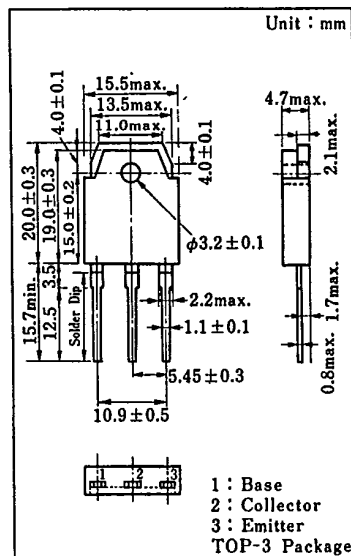
2SB812, 2SB812A とコンプリメンタリ/Complementary Pair
with 2SB812, 2SB812A

■ 特徴/Feature

- コレクタ損失 P_C が大きい。/Large P_C

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	60	V
2SD1032A		80	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	60	V
2SD1032A		80	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	8	A
コレクタ電流	I_C	4	A
コレクタ損失 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	P_C	60	W
接合部温度	T_J	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

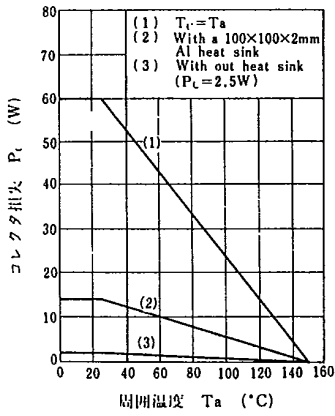
Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ しゃ断電流	I_{CEO}	$V_{CE}=30\text{V}, I_B=0$			700	μA
		$V_{CE}=60\text{V}, I_B=0$			700	
コレクタ しゃ断電流	I_{CES}	$V_{CE}=60\text{V}, V_{BE}=0$			400	μA
		$V_{CE}=80\text{V}, V_{BE}=0$			400	
コレクタ・ エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C=30\text{mA}, I_B=0$	60			V
			80			
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$			1	mA
直流電流増幅率	h_{FE1} *	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=1\text{A}$	40		250	
	h_{FE2}	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=3\text{A}$	15			
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=3\text{A}$			2	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=4\text{A}, I_B=0.4\text{A}$		1.5		V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C=4\text{A}, I_{B1}=-I_{B2}=0.4\text{A}$		0.2		μs
ターンオフ時間	t_{off}			1.4		μs

* h_{FE1} ランク分類/ h_{FE1} Classifications

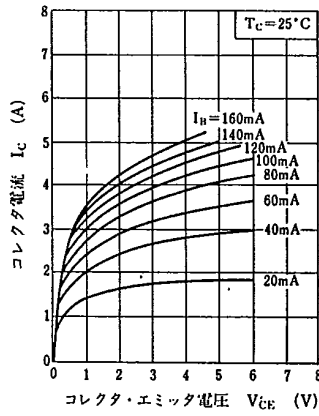
Class	R	Q	P
h_{FE1}	40~90	70~150	120~250

T-33-11

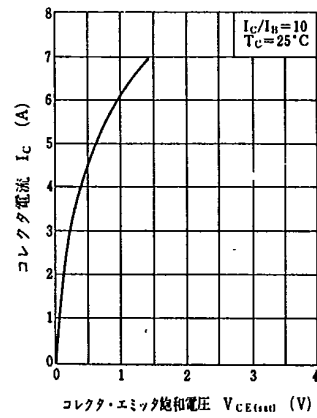
$P_C - T_a$



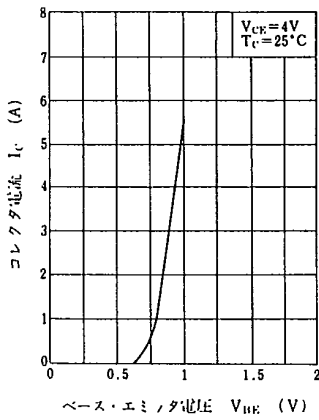
$I_C - V_{CE}$



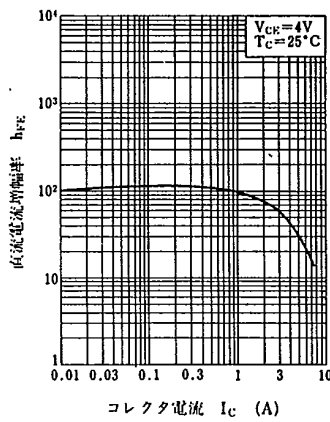
$I_C - V_{CE(sat)}$



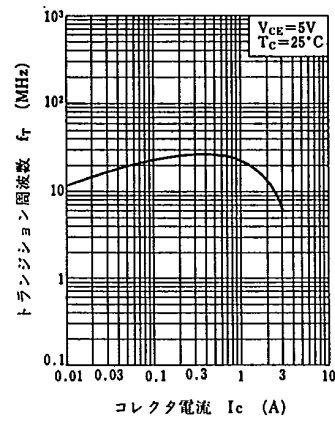
$I_C - V_{BE}$



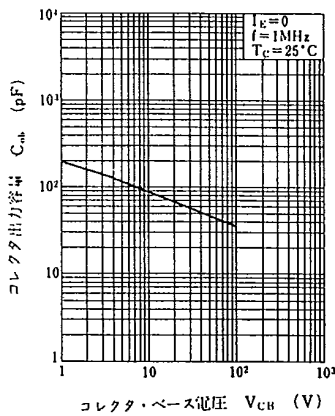
$h_{FE} - I_C$



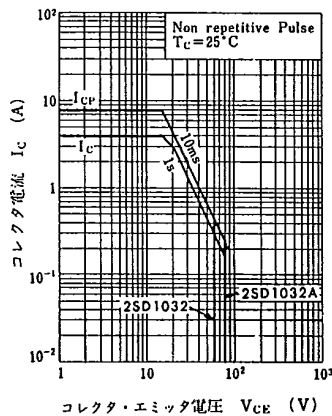
$f_T - I_C$



$C_{ob} - V_{CB}$



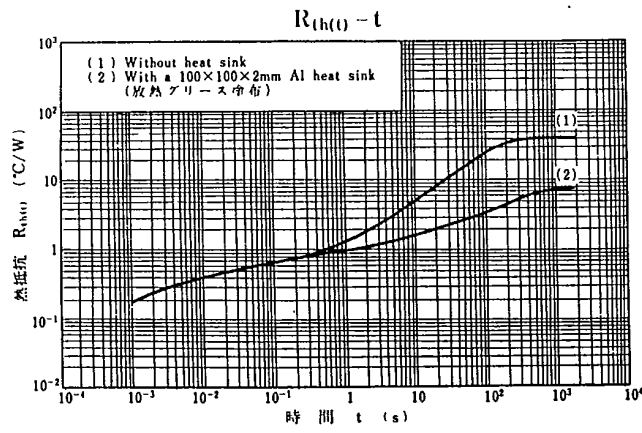
安全動作領域 ASO



トランジスタ

2SD1032, 2SD1032A

T-33-11



トランジスタ

2SD1043

2SD1043

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形ダーリントン / Si NPN Triple
Diffused Planar Darlington

大電力スイッチング用 / High Power Switching

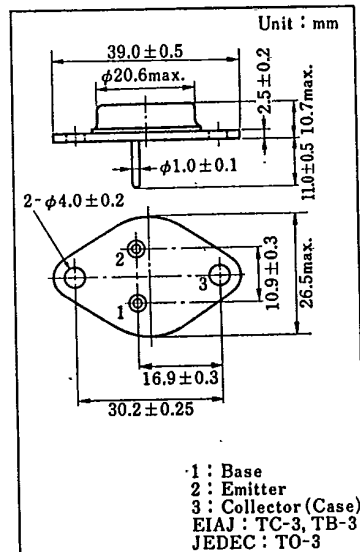
■ 特徴 / Features

- エネルギー耐量が大い。 / Large energy handling capability
- イグナイタ用に最適。 / Suitable for ignitor

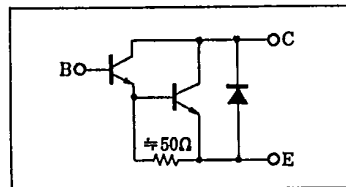
■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V _{CBO}	400	V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CER} *	400	V
エミッタ・ベース電圧	V _{EBO}	10	V
せん頭コレクタ電流	I _{CP}	10	A
コレクタ電流	I _C	5	A
コレクタ損失 (T _C = 25 °C)	P _C	80	W
接合部温度	T _J	150	°C
保存温度	T _{stg}	-65 ~ +150	°C

* R_{BE} = 220Ω



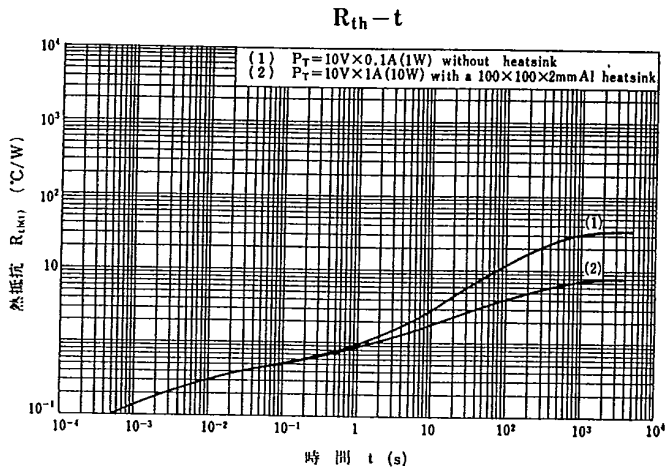
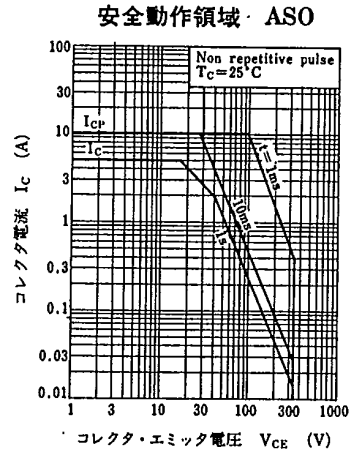
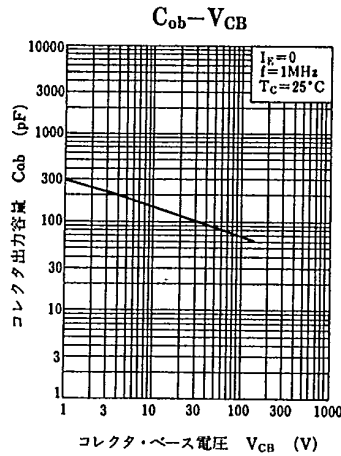
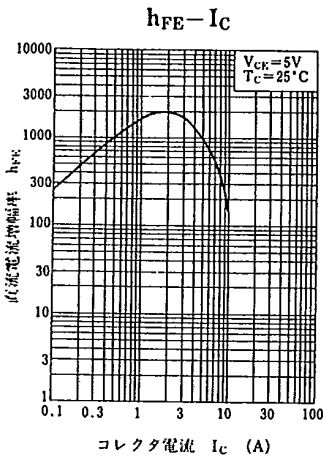
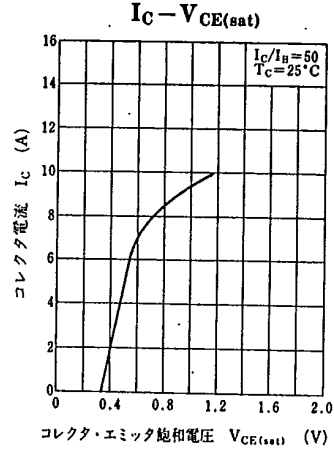
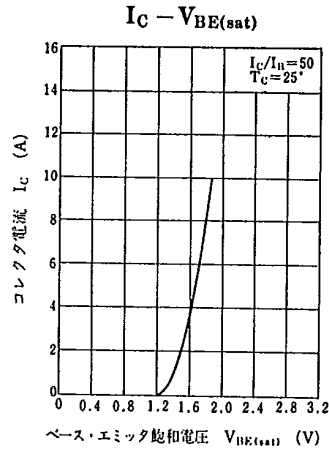
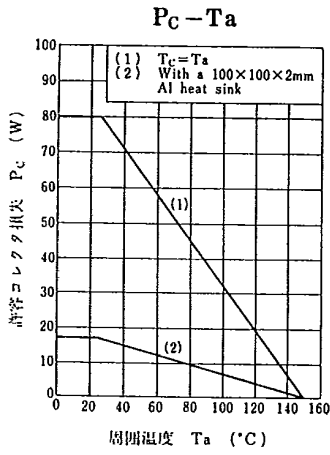
内部接続図 / Connection Diagram



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I _{CEO}	V _{CE} = 300 V, I _B = 0			500	μA
	I _{CER}	V _{CE} = 350 V, R _{BE} = 220 Ω			500	μA
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CER(sus)}	I _C = 5 A, L = 5 mH, R _{BE} = 220 Ω	400			V
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} = 5 V, I _C = 5 A	400		2000	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = 5 A, I _B = 0.1 A			1.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C = 5 A, I _B = 0.1 A			2	V
エネルギー耐量	E _{sfb}	I _C = 7.8 A, L = 10 mH R _{BE} = 220 Ω, V _Z = 400 V	300			mJ

T-33-29





LittleDiode supplies new, hard to find or obsolete electronic components and semiconductors all over the world.

With over two million different components listed you are sure to find the part you need.

Feel free to visit us today at our online store:

LittleDiode.com

Looking forward to providing you with the best possible service.